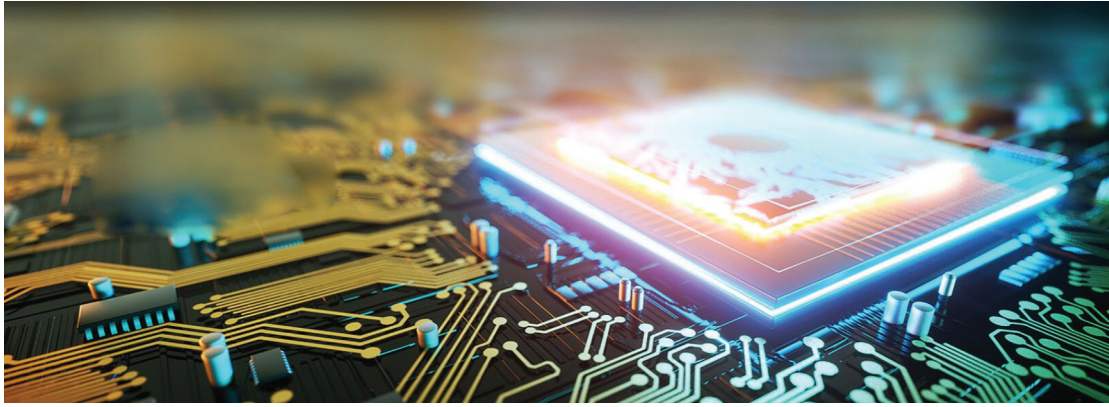




**REASUNOS**

Your Professional Semiconductor Partner



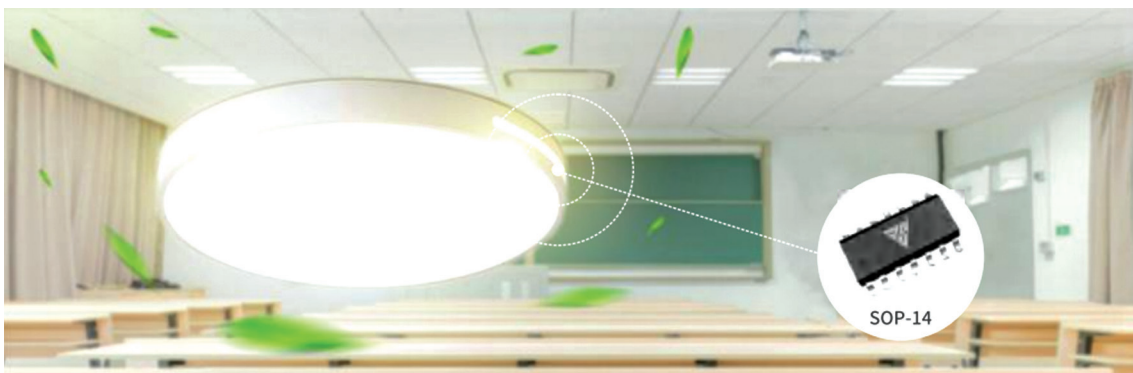
## Микросхемы LED драйверов

**Преимущества:** высокая мощность, высокая эффективность, сверхмалые фликеры, управление первичной цепи, экономичность решения, сверхнизкие пульсации выходного тока (менее 2%)

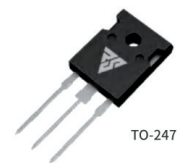
**Применение:** светодиодные драйверы постоянного тока, LLC резонансные схемы управления

**Модели:** RSC6105S, RSC6107S, RSC6112S, RSC6120S

№	Вывод	Функция
1	VIN	Вход enable высокого напряжения
2	NC	-
3	VCC	Питание
4	NC	-
5	FB	Вход обратной связи по напряжению
6	CS	Токовый вход
7	GND	Земля
8	PGND	Земля питания
9	LO	Выход нижнего плеча полумостового драйвера
10	PVCC	Питание
11	NC	-
12	HS	Земля высокого плеча полумоста
13	HO	Выход высокого плеча драйвера полумоста
14	HB	Питание высокого плеча полумостового драйвера



# SiC полевые транзисторы



TO-247

Наименование	Полярность	Ток стока, А	Напр-е сток-исток, В	Сопротивление сток-исток открытого канала		Корпус
				тип., мОм	макс., мОм	
RSM065040W	N	72	650	40	55	TO-247-3
RSM065040Z	N	72	650	40	55	TO-247-4
RSM120025W	N	90	1200	25	34	TO-247-3
RSM120025Z	N	90	1200	25	34	TO-247-4
RSM120040W	N	60	1200	40	55	TO-247-3
RSM120040Z	N	60	1200	40	55	TO-247-4
RSM120080W	N	36	1200	80	98	TO-247-3
RSM120080Z	N	36	1200	80	98	TO-247-4
RSM120160W	N	18	1200	160	196	TO-247-3
RSM120160Z	N	18	1200	160	196	TO-247-4
RSM1701K0W	N	5	1700	1000	1300	TO-247-3
RSM1701K0Z	N	5	1700	1000	1300	TO-247-4
RSM170045W	N	72	1700	45	70	TO-247-3
RSM170045Z	N	72	1700	45	70	TO-247-4

# SiC диоды Шоттки



Наименование	Электрические характеристики (при 25°C)				Корпус
	Прямое напр-е, В	Прямой ток, А (TC=145°C)	Обратный ток, мА	Обратное напр-е, В	
RSS04065*	1.4	4	1	650	DFN5*6/TO-252/220-2L
RSS06065*	1.4	6	1	650	DFN5*6/TO-252/220-2L
RSS08065*	1.4	8	1	650	DFN5*6/TO-252/220-2L
RSS10065*	1.4	10	1	650	DFN5*6/TO-252/ TO-220-2L
RSS20065W	1.4	20	2	650	TO-247-2L
RSS30065K	1.4	30	1	650	TO-247-3L
RSS60065K	1.5	60	2	650	TO-247-3L
RSS10120A	1.55	10	2	1200	TO-220-2L
RSS15120W	1.55	15	5	1200	TO-247-2L
RSS20120W	1.55	20	5	1200	TO-247-2L
RSS30120K	1.55	30	5	1200	TO-247-3L
RSS40120K	1.55	40	5	1200	TO-247-3L

\*Маркировка корпуса: A - TO-220-2L, D - TO-252, W - TO-247-2L, K - TO-247-3L



TO-220F

## Высоковольтные полевые транзисторы

Наименование	Полярность	Ток стока, А	Напр-е сток-исток, В	Сопротивление сток-исток открытого канала		Корпус
				тип., Ом	макс., Ом	
RS2N65*	N	2	650	4.1	4.8	TO-220F/251/252
RS4N65*	N	4	650	2.1	2.6	TO-220F/251/252
RS5N65*	N	5	650	1.9	2.4	TO-220F/251/252
RS6N65*	N	6	650	1.65	1.8	TO-220F/251/252
RS7N65*	N	7	650	1.1	1.4	TO-220F/251/252
RS8N65F	N	8	650	1.1	1.3	TO-220F
RS10N65D	N	10	650	0.9	1.05	TO-252
RS10N65F	N	10	650	0.68	0.85	TO-220F
RS12N65F	N	12	650	0.56	0.72	TO-220F
RS15N65F	N	15	650	0.55	0.68	TO-220F
RS16N65F	N	16	650	0.42	0.52	TO-220F
RS20N65F	N	20	650	0.36	0.4	TO-220F
RS840*	N	8	500	0.68	0.85	TO-220/252
RS9N50F	N	9	500	0.65	0.8	TO-220F
RS10N50F	N	10	500	0.6	0.75	TO-220F
RS13N50F	N	13	500	0.37	0.45	TO-220F
RS15N50F	N	15	500	0.35	0.42	TO-220F
RS18N50F	N	18	500	0.27	0.32	TO-220F
RS20N50F	N	20	500	0.2	0.26	TO-220F
RS20N50W	N	20	500	0.23	0.28	TO-247-3
RS25N50W	N	25	500	0.14	0.18	TO-247-3
RS28N50W	N	28	500	0.13	0.18	TO-247-3
RS30N50W	N	30	500	0.08	0.1	TO-247-3

\*Маркировка корпуса: F – TO-220F, D - TO-252, MD – TO-251 с коротким выводом, W - TO-247-2L, P – TO-3P

# Сверхвысоковольтные полевые транзисторы

Наименование	Полярность	Ток стока, А	Напр-е сток-исток, В	Сопротивление сток-исток открытого канала		Корпус
				тип., Ом	макс., Ом	
RS6N70*	N	6	700	1.3	1.6	TO-220F/251/252
RS11N70F	N	11	700	0.7	0.85	TO-220F
RSU15N70F	N	15	700	0.235	0.28	TO-220F
RS18N70F	N	18	700	0.45	0.55	TO-220F
RS4N80F	N	4	800	3	3.6	TO-220F
RS8N80F	N	8	800	1.3	1.5	TO-220F
RS10N80*	N	10	800	0.92	1.15	TO-220F/TO-3P
RS12N80*	N	12	800	0.67	0.8	TO-220F/TO-3P
RS4N90F	N	4	900	3	3.5	TO-220F
RS9N90*	N	9	900	1	1.2	TO-220F/TO-3P
RS11N90P	N	11	900	0.75	0.96	TO-3P
RS8N120W	N	8	1200	1.3	1.6	TO-247-3
RS4N150W	N	4	1500	4.5	6	TO-247-3

Перечислены не все наименования, транзисторы с другими характеристиками могут быть предложены по запросу

## Multi-EPI super junction MOSFET

Наименование	Полярность	Ток стока, А	Напр-е сток-исток, В	Сопротивление сток-исток открытого канала		Корпус
				тип., Ом	макс., Ом	
RSU7N65*	N	7	650	560	650	TO-220F/251/252
RS65R600*	N	7	650	520	600	TO-220F/251/252
RSU12N65*	N	12	650	380	420	TO-220F/251/252
RS65R380*	N	12	650	340	380	TO-220F/251/252
RS65R280F	N	15	650	240	280	TO-220F
RS65R190F	N	20	650	170	190	TO-220F
RS60R130F	N	30	650	110	130	TO-220F
RS65R099W	N	40	650	86	99	TO-247-3
RS60R070W	N	47	650	60	75	TO-247-3
RS65R041W	N	70	650	36	41	TO-247-3

\*Маркировка корпуса: F – TO-220F, D - TO-252, MD – TO-251 с коротким выводом, W - TO-247-2L, P – TO-3P

# Высоковольтные транзисторы с встроенным диодом

Наименование	Полярность	Ток стока, А	Напр-е сток-исток, В	Сопротивление сток-исток открытого канала		Диод Trr (нС)	Корпус
				тип., Ом	макс., Ом		
RSF5N50*	N	5	500	1.5	1.85	61	TO-220F/251/252
RSF7N50F	N	7	500	1.1	1.3	87	TO-220F
RSF8N50F	N	8	500	0.8	0.95	100	TO-220F
RSF13N50F	N	13	500	0.52	0.62	107	TO-220F
RSF15N50F	N	15	500	0.43	0.5	127	TO-220F
RSF25N50F	N	25	500	0.28	0.35	150	TO-220F
RSF4N60*	N	4	600	2.3	2.7	83	TO-220F/251/252
RSF6F60F	N	6	600	1.7	2	87	TO-220F
RSF7N60F	N	7	600	1.1	1.3	100	TO-220F
RSF10N60F	N	10	600	0.75	0.85	107	TO-220F
RSF12N60F	N	12	600	0.63	0.75	127	TO-220F
RSF6N70*	N	6	700	1.5	1.8	100	TO-220F/251/252

Перечислены не все наименования, транзисторы с другими характеристиками могут быть предложены по запросу



# IGBT транзисторы

Наименование	Ток коллектора, А (при 100°C)	Напр-е к-э, В	Напр-е к-э насыщ., В	Напр-е затво- ра порог., В	Крутизна, нS	Корпус
RSG15N65F	15	650	1.65	5	60	TO-220F
RSG20N65F	20	650	1.9	5	60	TO-220F
RSG30N65W	30	650	1.9	4.6	140	TO-247
RSG60N65W	60	650	1.85	5	185	TO-247
RSG15N120W	15	1200	1.7	6	330	TO-247
RSG25N120W	25	1200	1.65	6	200	TO-247
RSG40N120W	40	1200	2	5.8	230	TO-247

Перечислены не все наименования, транзисторы с другими характеристиками могут быть предложены по запросу

## Низковольтные транзисторы

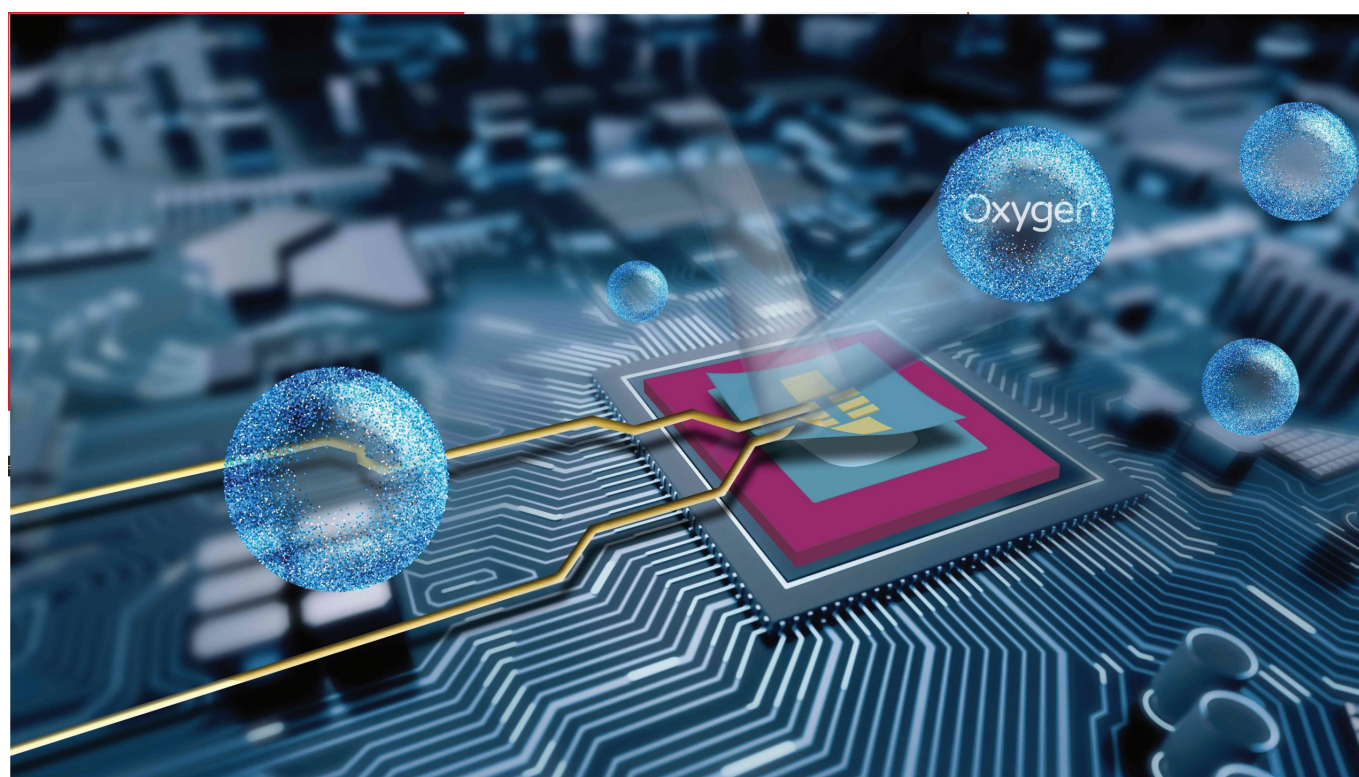
Наименование	Поляр- ность	Ток стока, А	Напр-е сток- исток, В	Сопротивление сток-исток открытого канала		Корпус
				тип., Ом	макс., Ом	
RS2301E	P	-3.4	-20	50	65	SOT-23
RS2302E	N	4	20	21	27	SOT-23
RS3415E	P	-4	-20	38	48	SOT-23
RS20N90D	N	90	20	3.7	5	TO-252
RS3401E	P	-4.2	-30	48	55	SOT-23
RS3400E	N	5.8	30	28	35	SOT-23
RS4435	P	-11	-30	15	20	SOP-8
RS30N60*	N	60	30	7	9	TO-220/TO-252
RS30N86D	N	86	30	3.6	5	TO-252
RS2310E	N	3	60	/	100	SOT-23
RS60N30D	N	30	60	22	35	TO-252
RS60N50*	N	50	60	14	20	TO-220/TO-252
RS85N150*	N	150	85	2.8	3.6	TO-220/TO-263
RS100N57T	N	57	100	13	16.5	TO-220
RS100N100T	N	100	100	7	8	TO-220
RS100N135T	N	135	100	3.7	4.5	TO-220
RS100N60G	N	60	100	7.2	8	DFN5*6
RS100N85G	N	85	100	5.8	6.5	DFN5*6
RS100N125G	N	125	100	4	4.6	DFN5*6
RS100N150G	N	150	100	3.5	4	DFN5*6

\*Маркировка корпуса: F – TO-220F, D - TO-252, MD – TO-251 с коротким выводом, W - TO-247-2L, P – TO-3P

## Диоды Шоттки с низким прямым напряжением

Наименование	Ток, А	Обратное на- пр-е, В	Электрические характеристики (при 25°C)		Корпус
			Прямое напр-е, В макс.	Обратный ток, мА макс.	
MBR1045LCT	10	45	0.46	0.1	TO-220AB
MBR10100LCT	10	100	0.72	0.1	TO-220AB
MBR10200LCT	10	200	0.89	0.2	TO-220AB
MBR2045LCT	20	45	0.52	0.1	TO-220AB
MBR2060LCT	20	60	0.55	0.1	TO-220AB
MBR20100LCT	20	100	0.7	0.1	TO-220AB
MBR20200LCT	20	200	0.89	0.1	TO-220AB
MBR20300LCT	20	300	0.89	0.1	TO-220AB
MBR3045LCT	30	45	0.53	0.1	TO-220AB
MBR30100LCT	30	100	0.73	0.3	TO-220AB
MBR30200LCT	30	200	0.89	0.3	TO-220AB
MBR30300LCT	30	300	0.92	0.3	TO-220AB

Серия MBR включает диоды в корпусе TO-220AB, также доступна серия диодов MBRF в корпусе ITO-220





# Диоды Шоттки

Наименование	Прямой ток, А	Обратное напряжение, В	Электрические характеристики (при 25°C)		Корпус
			Прямое напр-е, В макс.	Обратный ток, мА макс.	
MBR10100CT	10	100	0.85	0.2	TO-220AB
MBR10150CT	10	150	0.87	0.2	TO-220AB
MBR10200CT	10	200	0.92	0.2	TO-220AB
MBR2045CT	20	45	0.6	0.2	TO-220AB
MBRF2045CT	20	45	0.6	0.2	TO-220F
MBR2060CT	20	60	0.78	0.2	TO-220AB
MBR20100CT	20	100	0.85	0.2	TO-220AB
MBRF20100CT	20	100	0.85	0.2	TO-220F
MBR20150CT	20	150	0.9	0.2	TO-220AB
MBR20200CT	20	200	0.95	0.2	TO-220AB
MBR3045CT	30	45	0.65	0.2	TO-220AB
MBR30100CT	30	100	0.88	0.2	TO-220AB
MBR30150CT	30	150	0.88	0.2	TO-220AB
MBR30200CT	30	200	0.9	0.2	TO-220AB
MBR4060CT	40	60	0.75	0.2	TO-247S
MBR40100CT	40	100	0.85	0.2	TO-220AB
MBR40100PTS	40	100	0.85	0.2	TO-247S
MBR40200CT	40	200	0.9	0.2	TO-247S
MBR40200PTS	40	200	0.9	0.2	TO-247S
MBR4060PTS	40	60	0.75	0.2	TO-220AB
MBR6060PTS	60	60	0.7	0.2	TO-247S

Диоды серии MBR производятся в корпусе TO-220AB, так же производятся диоды серии PTS в корпусе TO-247 и серии MBRF в корпусе TO-220.

Перечислены не все наименования, транзисторы с другими характеристиками могут быть предложены по запросу

# REASUMOS

[www.platan.ru](http://www.platan.ru)

